

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
G02F 1/1335

(11)
(43)

10-2004-0067982
2004 07 30

(21) 10-2004-0004050
(22) 2004 01 20

(30)	JP-P-2003-00015403	2003	01	23	(JP)
	JP-P-2003-00015406	2003	01	23	(JP)
	JP-P-2003-00015407	2003	01	23	(JP)

(71) 가 가
 1 3-12

(72)	가 가	8	가 가
	가 가	8	가 가

(74)

:

$$(54) \quad \begin{aligned} & \text{[} \langle \text{ } \rangle \text{]}_{\text{CP}} \text{ [} \langle \text{ } \rangle \text{]}_{\text{CP}} \text{ [} \langle \text{ } \rangle \text{]}_{\text{CP}} \\ & \text{[} \langle \text{ } \rangle \text{]}_{\text{CP}} \text{ [} \langle \text{ } \rangle \text{]}_{\text{CP}} \text{ [} \langle \text{ } \rangle \text{]}_{\text{CP}} \end{aligned}$$

(A) $\frac{1}{\Gamma} \left(\frac{1}{\Gamma} \right) \frac{1}{\Gamma}$

가
(),
(),
4-57017 4-177216).
가
8-278491).
가 가
1
STN
1/4 1/2 1/4
1/4 1/2 3236304
가
가 가
8-278491
1 , (1)
(A) 1 , (2) (A)
(3) / / () / 2
3
2 ,
/ /

가

(가) , () / 가

-2-

, N, N-

, N, N-

, N-

가

가

2

가

50 μm , 0.2 μm () 20 μm , 0.3 μm 10 μm 0.1 μm

가

10 300 () 30 250 가
가 3 60 , 10 30 가
가 60 3

가

D

가

() 가

M

MD

가

가

(1) (2)

()

1 2000 mJ, 10 1000 mJ

2 10 kV 200 kV, 50 kV 100 kV

1 50 μ m, 2 30 μ m, 3 10 μ m

가

ITO(Indium Tin Oxide)

가 0.05 5 %, 가 0.1 0.01 10 %

가 가 가 가 가

가

4- -1

4- -1,

가 50 %, 30 % 가 가 가

가

30 cm/) 0.38 12 N/m, 0.38 8.0 N/m (180 °

가

가

가

16 100 μm,

25 50 μm가 가

가

(PVA) 1 2 1

MD

), TD ()

(to) 가

(PVA) PVA PVA 2 , - , PVA

(1)

()

[(A)]

$$/ \quad (1)/$$
$$\begin{array}{ccc} / & (1) / & / \end{array} \quad (2)$$

· , , 「 / 」 , 가

$$1, \quad (A) \quad .$$
$$2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right) = 1 \quad (A)$$
$$, \quad (A)$$
$$I \quad I \quad (\quad)I$$
$$I \quad I \quad (\quad)I$$
$$/ \quad / \quad / \quad (\quad) /$$

3 •

$$I \quad (\quad) / \quad / \quad (\quad) /$$
$$I \quad (\quad) / \quad / \quad / \quad (\quad) /$$
$$I \quad (\quad) / \quad I \quad I \quad I \quad (\quad) /$$
$$I \quad I \quad (\quad) \quad I \quad I \quad (\quad) \quad I$$
$$I \quad I \quad (\quad) \quad I \quad I \quad (\quad) \quad I$$
$$I \quad I \quad I \quad (\quad) \quad I \quad I \quad (\quad) \quad I$$

(2)

)

가

$$\begin{array}{l} / \quad (1) / \\ / \quad (1) / \quad / \quad (2) \end{array}$$

(3)

(A)

$$1 \quad , \quad (A) \quad , \quad (2)/ \quad , \quad (2)/ \quad , \quad (1)/ \quad (2) /$$

 $(2) \quad , \quad 3 \quad , \quad (2)$
$$\begin{array}{ccccccc} I & & (&) & / & & / & & / & & / & & (&) & / \\ I & & (&) & / & & / & & (&) & / & & / & & / \end{array}$$

가 .

가

가

가

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \end{array} \right)$$

0.3 μm 40 μm , 0.5 μm 10 μm , (Tg) 20 , 50 ,

가

가 가 가 , 가 가, 가

1

300 μm 450 μm 350 μm

STN, TN, O

CB, HAN

TN

1/4 EL

0 nm 1/4 550 nm 1/2 1/2 1/4 1/4 55 (遅相軸)

1/4 90 nm 160 nm, 120 nm 150 nm 70 nm 180 nm, 180 nm 320 nm, 200 nm 300 nm, 220 nm 280 nm

1/4 1/2 가 (Δn) (d)

[]

550 nm [(Δn) (d)]

[1]

60 mmol 50 mmol, 2, 6- 50 mmol, 40 mmol, 60 mg, 270 12

.6 g [(1)] [/ (6/4)] 14 : 30

] 0.16 dl/g, 112 250 (DSC)

20 g (1) 80 g N- -2- (, 210 20

0.7 μm

[2]

1 1.4 μm

[1]

1 가 가) 5 μm ((1) UV (UV-3400, (1)(S10, 가 가) 25 μm 600 mJ UV (1) (PET) (1) , PET (1)/ (1)/ / 가 (1) PET (1) , PET (1) (1)/ (A) , PET (1) (1)/ (A) Δnd 140 nm .

(A) UV (UV-3400) 5 μm (2) 600 mJ UV (2) , PET (1)/ (1)/ / (2)/ (60 μm , Δnd 270 nm)

가 가 SQW-862) , PET (1) (180 μm ; 가가 / 277 μm (2)/ / (1) .

[2]

1 TFT 가 , 500 , 80 , 500 2 60 , 90 % RH

[3]

2 가 가) 5 μm (UV (UV-3400, (60 μm , Δnd 275 nm) 600 mJ UV , / / . 가가 가 가 SQW-862) 25 μm (180 μm ; 272 μm / / .

[4]

3 TFT 가 , 500 , 80 , 500 2 60 , 90 % RH

[5]

1 가 가) 5 μm (UV (UV-3400, (1)(S10, 가 가) 25 μm 600 mJ UV (1) (PET) (1) , PET (1)/ (1)/ / 가 (1) PET (1) , PET (1)

(1) , PET (1)/ (1)/ / 가
 PET (1)
 , 25 μm UV (UV-3400) 5 μm (2) , (2)
 PET (2)(S10) 600 mJ UV (2)
 (A) , PET (1) (1)/ (2)/PET (2)
 , PET (2) (A) Δnd 140 nm .
 (A) (60 μm , Δnd 270 nm) 25 μm
 (1)/ / (2)/PET (2)

가 가 가 (25 μm) (180 μm ;
 / / SQW-862) , PET (2) / /
 (1)/ / (2) .
 300 μm .

[6]

5 TFT
 가 ,
 60 , 90 % RH 500 , 80 , 500 2 .

[1]

270 nm) 25 μm (1)(60 μm , Δnd 135 nm) (2)(60 μm , Δnd (2)
 , (1)/ /

가 가 가 (2) 25 μm (180 μm ;
 SQW-862) , / / (2)/ /
 (1) . 350 μm .

[2]

(1)(80 μm , Δnd 275 nm ; JSR 가 가)
 PET 25 μm , 180 μm ; 가 가
 가 SQW-862) / / (1)/ / PET 가
 JSR 가 가 PET) , / / (1)/ / (2)(80 μm , Δnd 130 nm ; (2)
 390 μm .

가 가 .

(57)

1.

(A) 1 ,

(A) , • / / / () / 2 ,

3

2.

, , / / , • .

3.

(1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (1) / (2)/ , (2) (A) 1 , (1)/

(A) (1)/ () / , • , (2)/ (2)/ / (2) (2) 3

4.

1 3 , .

5.

1 3 .

6.

1 3 .

7.

5 6 .

专利名称(译)	一种制造光学层压板的方法，由该层压板组成的椭圆偏振板，圆偏振板和液晶显示器		
公开(公告)号	KR1020040067982A	公开(公告)日	2004-07-30
申请号	KR1020040004050	申请日	2004-01-20
[标]申请(专利权)人(译)	新日本石油株式会社 有限公司以尼赫鲁，GB第十部分		
申请(专利权)人(译)	有限公司集团尼赫鲁点 ⁻ x		
当前申请(专利权)人(译)	有限公司集团尼赫鲁点 ⁻ x		
[标]发明人	HOSAKI KENJI 호사끼겐지 SATO HARUYOSHI 사또하루요시		
发明人	호사끼겐지 사또하루요시		
IPC分类号	G02F1/1335 G02B5/30		
代理人(译)	CHU，晟敏		
优先权	2003015407 2003-01-23 JP 2003015406 2003-01-23 JP 2003015403 2003-01-23 JP		
其他公开文献	KR100746806B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

由粘合液晶材料层后的第一工艺和高分子拉伸薄膜/粘合剂层/液晶材料层组成的层压板可以得到液晶材料层关于粘合液晶材料后的第一道工序在粘合剂层剥离取向基板并将液晶材料层转移到再利润基板中之后，在取向基板上形成的液晶取向用重微利润基板固定。获得由重微利润基底/粘合剂层/液晶材料层组成的层压体 (A)。关于高分子，在其制造光学层压体的方法上形成的液晶取向或第三工艺的取向基板在点胶粘合剂层之后焊接层压体 (A) 和高分子拉伸膜。剥掉了重新的微薄层压板的利润基板和获得由重微利润基板/粘合剂层/液晶材料层/粘合剂层/高分子拉伸膜组成并将偏振板焊接到粘合剂层或高分子层压板的第二层工艺固化后的拉伸薄膜用粘合剂层后的高分子拉伸薄膜粘合。层压体的高分子拉伸薄膜侧，以及通过液晶材料层平面中的点粘合剂层的偏振片可以称为光学多层体制造方法，其至少通过焊接过程。。使用该制造方法，提供了在没有支撑基板膜的情况下层叠由液晶材料层构成的光学元件的制造方法。取向基板，高分子拉伸膜，液晶材料层平面，胶水层。